

BRP50N20 (CS50N20P)

N-CHANNEL MOSFET/N 沟道 MOS 晶体管

用途：用于逆变器、UPS 电源。

Purpose: These devices are well suited for inverter、UPS.

特点：低反馈电容，开关速度快。

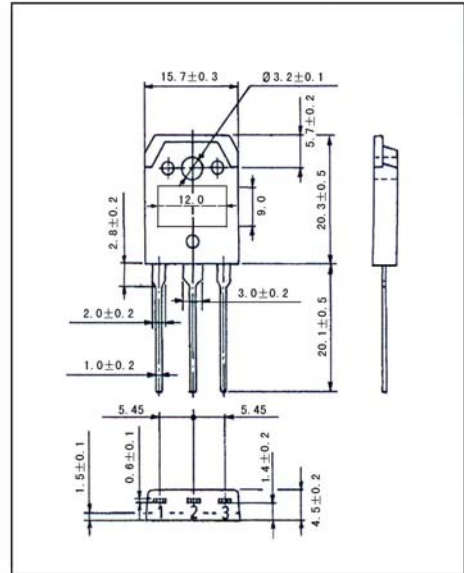
Features: Low effective output capacitance, high switch speed.

极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{DSS}	200	V
I _D (Tc=25°C)	50	A
I _D (Tc=100°C)	35	A
I _{DM}	200	A
V _{GSS}	±20	V
E _{AS}	550	mJ
E _{AR}	30	mJ
I _{AR}	50	A
P _D (Tc=25°C)	300	W
T _J , T _{STG}	-55 to 175	°C

T0-3P

单位 :mm



引脚： 1.G 2.D 3.S

电性能参数/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Conditions		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
BV _{DSS}	V _{GS} =0V	I _D =250 μ A	200			V
I _{DSS}	V _{DS} =200V	V _{GS} =0V			10	μ A
I _{GSS}	V _{GS} =±20V	V _{DS} =0V			±100	nA
V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS}	I _D =250 μ A	2		4	V
R _{DS(on)}	V _{GS} =10V	I _D =28A		40	45	mΩ
g _{FS}	V _{DS} =15V	I _D =10A		60		S
V _{SD}	V _{GS} =0V	I _S =50A			1.5	V
C _{iss}	V _{DS} =25V V _{GS} =0V f=1.0MHz			7800		pF
C _{oss}				445		
C _{rss}				280		
t _{d(on)}	V _{DD} =100V I _D =28A R _G =1 Ω V _{GS} =10V			20		ns
t _r				70		
t _{d(off)}				63		
t _f				52		

BRP50N20 (CS50N20P)

